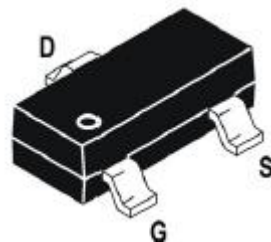




特点

- 超低电阻
- $R_{DS(ON)} < 60m\Omega @ V_{GS} = -4.5V$
- $R_{DS(ON)} < 75m\Omega @ V_{GS} = -2.5V$
- 可靠耐用
- ESD: HBM 2000V



产品应用

- 笔记本电脑的电源管理，便携式设备和电池供电的系统。

绝对最大额定值 ($T_A = 25^\circ C$, 除非另有说明)

符号	参数	值	单位
V_{DSS}	漏源电压	-9	V
V_{GSS}	栅源电压	± 6	
I_D	漏极电流	-3.5	A
I_{DM}	漏极脉冲电流	-7	
T_J	最大结温	150	$^\circ C$
T_{STG}	储存温度	-55 to 150	
$R_{\theta JA}^b$	结环热阻	150	$^\circ C/W$

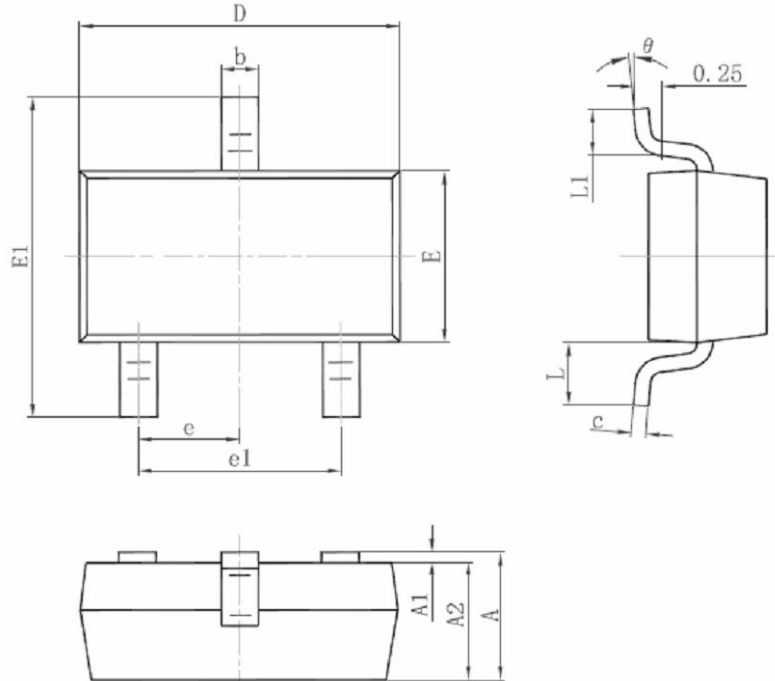
静态电特性 ($T_A = 25^\circ C$, 除非另有说明)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
静态特性						
BV_{DSS}	漏源击穿电压	$V_{GS} = 0V, I_{DS} = -250\mu A$	-8.4	-9		V
I_{DSS}	栅源短路时，漏极电流	$V_{DS} = -6V, V_{GS} = 0V,$			-1	μA
		$T_A = 85^\circ C$			-10	
$V_{GS(th)}$	栅极阈值电压	$V_{DS} = V_{GS}, I_{DS} = -250\mu A$	-0.35	-0.5	-1.4	V
I_{GSS}	栅漏电流	$V_{GS} = \pm 5V, V_{DS} = 0V$			± 100	nA
$R_{DS(ON)}$	内阻	$V_{GS} = -4.5V, I_{DS} = -3.0A$		55	60	m Ω
		$V_{GS} = -2.5V, I_{DS} = -2.0A$		70	75	
		$V_{GS} = -1.8V, I_{DS} = -1.0A$		110	120	
V_{SD}	二极管正向电压	$I_{SD} = -3.5A, V_{GS} = 0V$			-1.3	V
R_G	栅极输入电阻	$V_{GS} = 0, V_{DS} = 0, V$ Frequency = 1MHz	--	6	--	Ω



封装信息

SOT-23(小)



符号	毫米		英寸	
	最小	最大	最小	最大
A	0.900	1.150	0.035	0.045
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.050	0.035	0.041
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.080	0.150	0.003	0.006
D	2.800	3.000	0.110	0.118
E	1.200	1.400	0.047	0.055
E1	2.250	2.550	0.089	0.100
e	0.950 TYP.		0.037 TYP.	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.550 REF.		0.022 REF.	
L1	0.300	0.500	0.012	0.020
θ	0°	8°	0°	8°